

## 暫定規格

2SA659NP シリコンPNP三重拡散プレーナ型トランジスタ  
低周波小信号増幅一般用

- あらゆる低周波小信号増幅回路一般に応用でき 2SC1175NP とコンプリメンタリ・ペアが組めます。
- 特に出力15Wまでの低周波電力増幅段の励振用に最適です。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$ 

項目	記号	2SA659NP	単位
コレクタ・ベース電圧	$V_{\text{CBO}}$	-50	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{\text{CEO}}$	-50	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{\text{EBO}}$	-5	V
コレクタ電流	$I_{\text{C}}$	-200	mA
コレクタ損失	$P_{\text{C}}$	400	mW
接合部温度	$T_{\text{j}}$	125	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	$T_{\text{stg}}$	-40 ~ +125	$^\circ\text{C}$

電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$ 

項目	記号	条件	min.	typ.	max.	単位
コレクタしゃ断電流	$I_{\text{CBO}}$	$V_{\text{CB}} = -40\text{V}, I_{\text{E}} = 0$			-10	$\mu\text{A}$
エミッタしゃ断電流	$I_{\text{EBO}}$	$V_{\text{EB}} = -3\text{V}, I_{\text{C}} = 0$			-10	$\mu\text{A}$
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(\text{BR})\text{CEO}}$	$I_{\text{C}} = -5\text{mA}, R_{\text{BE}} = \infty$	-50			V
直流電流増幅率	$h_{\text{FE}}^*$	$V_{\text{CE}} = -6\text{V}, I_{\text{C}} = -50\text{mA}$	40	100	320	
利得帯域幅積	$f_{\text{T}}$	$V_{\text{CE}} = -6\text{V}, I_{\text{C}} = -10\text{mA}$		90		MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{\text{CE(sat)}}$	$I_{\text{C}} = -100\text{mA}, I_{\text{B}} = -20\text{mA}$			-1.5	V

\* 2SA659NP は 50mA  $h_{\text{FE}}$  によりつぎのように分類しています。

40	C	80	60	D	120	100	E	200	160	F	320
----	---	----	----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

